

プラズマCVD装置 CP-1900



＜平行平板型プラズマCVD＞

ステンレスチャンバー内に置かれた基板に発生したプラズマにより、成膜します。上部電極は、ガスシャワーが装着されており下部の基板ホルダーには、ヒーターが埋め込まれています。またコンパクトに出来ていますので、小さな実験室でも設置することができます。

プラズマCVD装置CP-1900仕様

○膜種	a-Si/Si ₃ N ₄
○炉体サイズ	φ 300mm × 250mm
○炉体材質	SUS316
○基板形状	4インチ 1枚
○到達圧力	× 10 ⁻² Pa 台 ※ 常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	× 10 ⁻¹ Pa 台 迄 3分以内 ※ 常温・無負荷・脱ガス時
○加熱温度	500℃
○圧力コントロール	自動
○ガス種	SiH ₄ /NH ₃ /H ₂ /N ₂
○電源	RF電源 13.56MHz 500W 自動マッチング 1台
○真空排気系	油回転ポンプ: 167L/min メカニカルブースターポンプ: 30m ³ /h
○真空計	ピラニ真空計/バロトロン真空計
○ユーティリティ	電気: AC200V 三相 10KVA 冷却水: 15L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25℃ 以下 循環 計装エア: 0.5MPa 以上